



中华人民共和国国家标准

GB 12565—90

半 导 体 器 件 光 电 子 器 件 分 规 范

Semiconductor devices
Sectional specification for optoelectronic devices
(可供认证用)

1990-12-12 发布

1991-10-01 实施

国 家 技 术 监 督 局 发 布

中华人民共和国国家标准

半 导 体 器 件 光 电 子 器 件 分 规 范

GB 12565—90

Semiconductor devices

Sectional specification for optoelectronic devices

(可供认证用)

1 范围

- 1.1 半导体光发射器件
 - a. 光电子显示器件;
 - b. 发光二极管(LED);
 - c. 红外发射二极管(IRED);
 - d. 激光二极管。
- 1.2 半导体光敏器件
 - a. 光敏二极管;
 - b. 光敏三极管;
 - c. 光控闸流晶体管。
- 1.3 半导体图像器件。
- 1.4 光耦合器。

2 总则

本规范应与其有关的总规范一起使用;本规范规定了评定半导体光电子器件所需的质量评定程序、检验要求、筛选顺序、抽样要求、试验和测试方法的细节。

2.1 有关文件

GB 4589.1(IEC 747-10/QC 700 000)《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》

2.2 温度的推荐值(优选值)

见 IEC 747-1《半导体器件 分立器件和集成电路第一部分总则》第 6.5 条。

2.3 电压和电流的推荐值(优选值)

见 IEC 747-1 第 6.6 条。

3 质量评定程序

3.1 初始的制造阶段和转包

初始的制造阶段为下述之一:

- a. 单晶半导体器件
改变纯 P 型或纯 N 型单晶半导体材料的第一道工序。
- b. 多晶半导体器件